ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 547.173+539.194

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН ДВУМЕРНЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ЛИСТОВ С ОКТАЭДРИЧЕСКИМИ 1,6-КАРБОРАНАМИ

© 2019 г. Д. В. Стегленко^{1,} *, С. А. Зайцев¹, Р. М. Миняев¹, В. И. Минкин¹

¹Южный федеральный университет, Институт физической и органической химии, Россия, 344090 Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, 194/2 *E-mail: sting@ipoc.sfedu.ru

> Поступила в редакцию 24.01.2019 г. После доработки 08.02.2019 г. Принята к публикации 15.02.2019 г.

С помощью квантово-химических расчетов в приближении теории функционала плотности с наложением периодических граничных условий исследованы структура и свойства двумерных листов, состоящих из 1,6-карборанов. Расчеты фононного дисперсионного спектра и зонной структуры показали, что двумерные листы динамически стабильны и относятся к непрямозонным полупроводникам с шириной запрещенной зоны ~2.5 эВ. Рассчитанные параметры механических свойств показали, что модуль Юнга для 1,6-карборановых 2D-нанослоев хотя и ниже, чем у однослойного листа гексагонального нитрида бора (*h*-BN), но превышает таковой для монослоя MoS₂.

Ключевые слова: октаэдраны, 1,6-клозокарбораны, двумерные материалы, электронная зонная структура, фононный спектр, DFT-расчеты

DOI: 10.1134/S0044457X19080166

введение

Изучение двумерных (2D) атомно-структурированных поверхностей началось с открытия необычных физико-химических свойств графена [1-7], обещающих обеспечить прорыв в дальнейшей миниатюризации электронных приборов и создании новых высокопрочных материалов [3-7]. Быстрый прогресс в открытии уникальных и технологически полезных свойств графена привел к широкому исследованию и открытию множества других стабильных материалов моноатомной толщины помимо графена [8-10]. Кроме этого направления исследований в последнее время большое внимание привлекают новые аллотропные модификации двумерных борных структур: борофен [11], α-бор [12] и другие [13–19], а также их соединения с кремнием [15], бериллием [16] и другие двумерные системы [8-10]. Расчеты [20] показали, что некоторые из листов бора могут иметь достаточно высокую температуру ($T_c \sim 10-20$ K) фазового перехода в сверхпроводящее состояние.

В последнее время с помощью методов квантовой химии был предсказан ряд устойчивых 3Dструктур углерода и бора – "супертетраэдран" [21, 22] и бора – "супертетраборан" [23, 24]. Дизайн этих структур был спроектирован путем замены атомов кристаллической решетки алмаза соответственно углеродными С₄- и борными В₄тетраэдрами. Попытки распространить этот подход на построение супертетраэдрического графана и борографана потерпели неудачу, так как соответствующие 2D-системы оказались динамически неустойчивыми [24] и, следовательно, не могли стабилизироваться в свободном состоянии без подложки. Однако мы ожидали, что более стабильные 2D-монослои, состоящие из полиэдров, построенных из атомов главной группы, могут быть получены при использовании других (не тетраэдрических) блоков, например октаэдров.

В настоящей работе представлены квантовохимические расчеты, выполненные методом теории функционала плотности, структуры и свойств двумерных плоскостей (рис. 1), состоящих из 1,6-карборановых $B_4C_2X_2$ (X = H, F, Cl) фрагментов.

Выбор 1,6-карборанов в качестве строительных блоков предлагаемого двумерного материала частично оправдан их многочисленными полезными техническими приложениями, в том числе нейтронно-захватной терапией и улучшением термостойкости адгезивов различных типов [25–27].

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Расчеты в супермолекулярном приближении проводили с помощью пакета Gaussian 16 [28] с функционалом B3LYP в базисе 6-311+G**. Оптимизацию геометрических параметров проводили



Рис. 1. Схематический вид двумерной структуры, состоящей из 1,6-карборанов $B_4C_2X_2$ (X = H, F, Cl). Атомы бора отмечены зеленым, атомы углерода – коричневым цветом. Серым цветом обозначены заместители X.

с использованием параметров opt = Tight и Grid = = UltraFine. Характер стационарной точки определяли с помощью расчета матрицы силовых констант (Гессиан). Расчеты бесконечных плоскостей проводили в программе VASP (Vienna Ab initio Simulation Package) [29–32] в базисе присоединенных плоских волн РАW [33, 34] с использованием функционала PBEsol [35]. Энергия плоских волн составляла 1000 эВ, порог минимизации волновой функции — 1×10^{-8} эВ. Разбиение зоны Бриллюэна проводили по методу Монхорст–Пэка [36] с автоматически созданной сеткой 25 × 25 × 1. Фононный спектр рассчитывали с помошью программы Phonopy [37] с использованием суперъячейки размером 2 × 2 × 1. При расчете электронной зонной структуры сетка k-точек зоны Бриллюэна была увеличена до 45 × 45 × 1. Для исключения влияния соседних слоев друг на друга было установлено межслойное расстояние 20 Å. Для визуализации исследуемых систем использована программа Веста [38].



Рис. 2. Дисперсионные кривые (слева) и плотность состояний (справа) фононного спектра для бесконечной двумерной структуры, состоящей из октаэдрических 1,6-карборановых единиц (рис. 1, X = H). В верхнем правом углу показана зона Бриллюэна и пути, по которым были рассчитаны дисперсионные кривые Γ –X–M– Γ –Z–R–A–Z.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Вначале были исследованы пространственная структура, динамическая устойчивость и электронные свойства двумерной поверхности, состоящей из незамещенных октаэдрических 1,6карборанов (рис. 1, X = H). Результаты расчета дисперсионных кривых фононного спектра для бесконечной двумерной структуры 1,6-карборанов, представленных на рис. 2, показывают, что ни одна из дисперсионных кривых во всей зоне Бриллюэна не попадает в отрицательную (мнимую) область. Это означает, что изученная двумерная плоскость динамически устойчива. Структурные характеристики двумерной структуры и отдельных молекул 1,6-карборана 1 и его димера 2 и тетрамера 3 представлены в табл. 1.



Рассчитанные структурные параметры 1,6карборана 1 хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными для газовой фазы [39–41] и ранее сообщавшимися теоретическими

результатами [42–47]. Согласно выполненным расчетам, длины всех связей в мономере 1, димере 2, тетрамере 3 и в октаэдрах, составляющих плоскость, отличаются не более чем на 0.01 Å.

Таблица 1. Длины связей и минимальная гармоническая колебательная частота ω_1 в 1,6-карборане 1, его димере 2, тетрамере 3 и в структуре бесконечной плоской поверхности, рассчитанные методами DFT: B3LYP/6-311+G(d, p) и PAW PBEsol

	$d, \mathrm{\AA}$									
Связь	мономер 1	димер 2	тетрамер 3	2D-лист						
	$C_2B_4H_2$									
С–Н	1.078	1.079 1.079		1.089						
C–B	1.624	1.625	1.6265	1.626						
B-B*	1.713	1.717	1.717 1.723							
B-B**	—	1.659	1.660	1.658						
ω_1, cm^{-1}	379.1 (B _{2U})	29.4(A _U)	26.8 (B _{1U})	Стабилен						
$C_2B_4F_2$										
C-F	1.339	1.339	1.339	1.332						
C–B	1.616	1.618	1.619	1.622						
B-B*	1.733	1.737	1.747	1.746						
B-B**	_	1.653	1.654	1.652						
ω_1, cm^{-1}	251.5 (E _U)	11.5 (A _U)	15.7 (B _{1U})	Стабилен						
$C_2B_4Cl_2$										
C–Cl	1.735	1.735	1.735 1.735							
C–B	1.621	1.623 1.624		1.627						
B-B*	1.726	1.730 1.735		1.738						
B-B**	—	1.648	1.648 1.655							
$ω_1$, cm^{-1}	161.6 (E)	19.9 (A)	17.5 (A)	Стабилен						

* Значение длины связи как среднее арифметическое длин связей, формирующих цикл В₄.

** Значение длины связи, соединяющей октаэдры.

Согласно расчетам, электронная зонная структура бесконечной плоскости, состоящая из структурных единиц 1,6-карборанов (рис. 3), имеет ширину запрещенной зоны между валентной зоной и зоной проводимости, равную 2.5 эВ, это свидетельствует о том, что система является непрямозонным полупроводником.

В табл. 2 представлены данные о значениях ширины запрещенной зоны и энергии когезии рассматриваемых плоских листов. Энергию когезии (в эВ атом⁻¹) рассчитывали по формуле [48, 49]:

$$E_{\text{kores}} = \frac{E_{\text{crp}} - (2E_{\text{C}} + 4E_{\text{B}} + 2E_{\text{X}})}{8},$$
 (1)

где $E_{\rm стр}$ — энергия рассматриваемой планарной структуры, $E_{\rm C}$, $E_{\rm B}$, $E_{\rm X}$ — энергии атомов C, B и X в основном состоянии, где X = H, F, Cl.

Следует отметить, что рассчитанные значения энергии когезии выше, чем для других 2D-материалов на основе гидридов бора (-5.04, $-5.02 \ \text{эB} \ \text{атом}^{-1}$) [50] и борофена ($-49.90 \ \text{эB} \ \text{атом}^{-1}$) [50].

Аналогичные расчеты 1,6-фтор- и хлорзамещенных однослойных листов также свидетельствуют об их динамической стабильности. Расче-

ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ том 64 № 8 2019

ты электронной зонной структуры этих систем показывают, что они также являются непрямозонными полупроводниками.



Рис. 3. Электронная зонная структура бесконечной плоскости, состоящая из структурных единиц 1,6-карборанов (X = H), вычисленных методом DFT PAW PBEsol (слева), и парциальные и полные электронные плотности (справа).

Таблица 2. Значения запрещенной зоны и энергии связи, рассчитанные методом DFT для двумерных монослоев, состоящих из октаэдрических 1,6-карборановых единиц

Соединение	Ширина запрещенной зоны, эВ	Энергия когезии, эВ атом ⁻¹
$C_2B_4H_2$	2.46	-5.92
$C_2B_4F_2$	2.63	-6.10
$C_2B_4Cl_2$	2.54	-5.75

Таблица 3. Вычисленные значения констант упругости $(c_{ij}, \text{ H м}^{-1})$, модуль Юнга $(Y_{2D}, \text{ H м}^{-1})$, коэффициент Пуассона (v) и статическая диэлектрическая постоянная ε_{ii}

Соединение	<i>c</i> ₁₁	<i>c</i> ₁₂	<i>c</i> ₆₆	Y _{2D}	ν	ϵ_{xx}	€ _{zz}
$C_2B_4H_2$	168.61	7.85	12.40	168.25	0.0465	1.90	1.58
$C_2B_4F_2$	169.30	5.15	11.63	169.14	0.0304	1.71	1.50
$C_2B_4Cl_2$	169.23	6.81	11.78	168.95	0.0402	2.46	2.54

В табл. З приведены рассчитанные константы эластичности, модуль Юнга и коэффициент Пуассона, которые характеризуют пластические и упругие свойства исследуемого материала. Поскольку исследуемый монослой изотропный, в таблице представлены только две упругие константы – c_{11} и c_{12} , а также модуль Юнга (Y_{2D}) и коэффициент Пуассона (v), которые рассчитывали по формулам:

$$Y_{2D} = \frac{c_{11}^2 - c_{12}^2}{c_{11}},$$
 (2)

$$v = \frac{c_{12}}{c_{11}}.$$
 (3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С применением методов квантовой химии и теории функционала плотности мы изучили новый 2D-материал, построенный на основе октаэдрического 1,6-карборана. Расчеты фононных и электронных зонных структур показали, что новый 2D-материал динамически устойчив и относится к непрямозонным полупроводникам с шириной запрещенной зоны ~2.5 эВ. Рассчитанная энергия связи показала, что предсказанная структура имеет более высокую стабильность по сравнению с борофеном и графеном [48]. Согласно рассчитанному значению модуля Юнга, предел прочности рассмотренного 2D-материала лежит в диапазоне значений прочности таких двумерных материалов, как однослойные MoS₂ и *h*-BN.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 16-13-10050).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V. et al. // Science. 2004. V. 306. P. 666.
- Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V. et al. // Nature. 2005. V. 438. P. 197.
- Wu J., Pisula W., Müllen K. // Chem. Rev. 2007. V. 107. P. 718.
- 4. Balandin A.A., Ghosh S., Bao W. et al. // Nano Lett. 2008. V. 8. P. 902.
- Meric I., Han M.Y., Young A.F. et al. // Nat. Nanotechnol. 2008. V. 3. P. 654.
- Soldano C., Mahmood A., Dujardin E. // Carbon 2010. V. 48. P. 2127.
- Geim A.K., Novoselov K.S. // Nat. Mater. 2007. V. 6. P. 183.
- *Gupta A., Sakthivel T., Seal S.* // Prog. Mater. Sci. 2015. V. 73. P. 44.
- Butler S.Z., Hollen S.M., Cao L. et al. // ACS Nano. 2013. V. 7. P. 2898.
- Molle A., Goldberger J., Houssa M. et al. // Nat. Mater. 2017. V. 16. P. 163.
- Piazza Z.A., Hu H.-S., Li W.-L. et al. // Nat. Commun. 2014. V. 5. P. 3113.
- Tang H., Ismail-Beigi S. // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 99. P. 115501.
- 13. Zhou X.-F., Dong X., Oganov A.R. et al. // Phys. Rev. Lett. 2014. V. 112. P. 085502.
- 14. *Penev E.S., Bhowmick S., Sadrzadeh A. et al.* // Nano Lett. 2012. V. 12. P. 2441.
- Wu X., Dai J., Zhao Y. et al. // ACS Nano 2012. V. 6. P. 7443.
- Ogitsu T., Schwegler E., Galli G. et al. // Chem. Rev. 2013. V. 113. P. 3425.
- 17. *Wu X., Dai J., Zhao Y. et al.* // ACS Nano 2013. V. 7. P. 880.
- Dai J., Zhao Y., Wu X. et al. // J. Phys. Chem. Lett. 2013. V. 4. P. 561.
- Yu X., Li L., Xu X.-W. et al. // J. Phys. Chem. C. 2012.
 V. 116. P. 20075.
- 20. Penev E.S., Kutana A., Yakobson B.I. // Nano Lett. 2016. V. 16. P. 2522.
- Minyaev R.M., Avakyan V.E. // Dokl. Chem. 2010. V. 434. P. 253. [Миняев Р.М. Авакян В.Е. // Докл. АН. 2010. Т. 434. С. 253.] https://doi.org/10.1134/S0012500810100010
- 22. Sheng X.-L., Yan Q.-B., Ye F. et al. // Phys. Rev. Lett. 2011. V. 106. P. 155703.
- 23. *Minyaev R.M.* // Russ. Chem. Bull. 2012. V. 61 P. 1673. [*Миняев Р.М.* // Изв. РАН. Сер. хим. 2012. Т. 9. C. 1657.] https://doi.org/10.1007/s11172-012-0232-1
- 24. Getmanskii I.V., Minyaev R.M., Steglenko D.V. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2017. V. 56 P. 10118.
- 25. Genady A.R. // Eur. J. Med. Chem. 2009. V. 44. P. 409.

- Sharapov V.M., Mirnov S.V., Grashin S.A. et al. // J. Nucl. Mater. 1995. V. 220–222. P. 730.
- Meshcheryakov A.I., Akulina D.K., Batanov G.M. et al. // Plasma Phys. Rep. 2005. V. 31. P. 452. [Мещеряков А.И., Акулина Д.К., Батанов Г.М. и др. // Физика плазмы. 2005. Т. 31. С. 496.] https://doi.org/10.1134/1.1947330
- Frisch M.J. et al. Gaussian 16, rev. B.01. Gaussian Inc. Wallingford CT, 2016.
- 29. Kresse G., Hafner J. // Phys. Rev. B. 1993. V. 47. P. 558.
- Kresse G., Hafner J. // Phys. Rev. B. 1994. V. 49. P. 14251.
- Kresse G., Furthmüller J. // Phys. Rev. B. 1996. V. 54. P. 11169.
- Kresse G., Furthmüller J. // Comput. Mater. Sci. 1996.
 V. 6. P. 15.
- 33. Blöchl P.E. // Phys. Rev. B. 1994. V. 50. P. 17953.
- Kresse G., Joubert D. // Phys. Rev. B. 1999. V. 59. P. 1758.
- Perdew J.P., Ruzsinszky A., Csonka G.I. et al. // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 100. P. 136406.
- Monkhorst H.J., Pack J.D. // Phys. Rev. B. 1976. V. 13. P. 5188.
- 37. Togo A., Tanaka I. // Scr. Mater. 2015. V. 108. P. 1.

- Koichi M., Fujio I. // J. Appl. Crystallogr. 2011. V. 44. P. 1272.
- 39. *Mastryukov V.S., Dorofeeva O.V., Vilkov L.V. et al.* // J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1973. P. 276.
- 40. *McNeill E.A., Gallaher K.L., Scholer F.R. et al.* // Inorg. Chem. 1973. V. 12. P. 2108.
- 41. Beaudet R.A., Poynter R.L. // J. Chem. Phys. 1970. V. 53. P. 1899.
- Buehl M., Schleyer P.v.R. // J. Am. Chem. Soc. 1992.
 V. 114. P. 477.
- 43. McKee M.L. // J. Am. Chem. Soc. 1992. V. 114. P. 879.
- 44. Slutsky V.G., Hofmann M., Schleyer P. von Rague // Mendeleev Commun. 1994. V. 4. P. 12.
- 45. Bausch J.W., Prakash G.K.S., Williams R.E. // Inorg. Chem. 1992. V. 31. P. 3763.
- 46. *Jemmis E.D., Subramanian G.* // J. Phys. Chem. 1994. V. 98. P. 9222.
- 47. Onak T., Jaballas J., Barfield M. // J. Am. Chem. Soc. 1999. V. 121. P. 2850.
- Sofo J.O., Chaudhari A.S., Barber G.D. // Phys. Rev. B. 2007. V. 75. P. 153401.
- Paulus B., Fulde P., Stoll H. // Phys. Rev. B. 1996. V. 54. P. 2556.
- Jiao Y., Ma F., Bell J. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2016. V. 55. P. 10292.